

РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ФОТОЭЛЕКТРОНИКИ

Конференц-зал ИФП СО РАН

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

9⁰⁰-10⁰⁰

Регистрация участников конференции

1-е заседание Председатель – А.Г. Милёхин

10⁰⁰ – 10¹⁵

Открытие конференции и школы. Вступительное слово.

Академик А.В. Латышев

10¹⁵ – 10⁴⁵

*Ю.Г.Сидоров¹, М.В.Якушев¹, И.В.Сабина¹,
Г.Ю.Сидоров¹, В.В.Васильев¹, Д.В.Марин¹,
С.А.Дворецкий¹, Н.Н.Михайлов¹, В.С.Варавин¹,
Д.Г.Икусов¹, А.В.Зверев¹, Ю.С.Макаров¹,
А.В.Предеин¹, И.В.Марчишин¹, А.В.Вишняков¹,
В.Г.Ремесник¹, Д.В.Горшков¹, А.В.Латышев¹, П.А.
Сысоев², К.С. Лопаткин².*

Полный цикл разработки и производства современных охлаждаемых ИК ФПУ на основе КРТ в ИФП СО РАН (**приглашенный доклад**)

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Филиал 46 ЦНИИ МО РФ, Мытищи.*

10⁴⁵ – 11¹⁵

К.О.Болтарь, И.Д.Бурлаков, А.В.Полесский,
Н.И.Яковлева

Фотосенсорика коротковолнового ИК диапазона спектра (**приглашенный доклад**)

ГНЦ РФ АО «НПО «Орион».

11¹⁵ – 11³⁰

Кофе-брейк

2-е заседание Председатель – Милёхин А.Г.

11⁴⁵ – 12⁰⁰ *С.Н.Подлесный¹, И.А.Карташов¹, С.М.Тарков¹, В.А.Володин¹, **В.П.Попов¹**, И.Н.Куприянов², Ю.Н.Пальянов², А.А.Емельянов³, Н.И.Тимошенко³, А.К.Ребров³.*

Квантовые сенсоры физических полей на ансамблях NV центров в алмазных наноструктурах.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск;*

³ *Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск.*

12⁰⁰ – 12¹⁵ ***Т.С.Шамирзаев¹**, М.С.Кузнецова², К.В.Кавокин², Д.С.Смирнов³, J.Rautert⁴, Д.Р.Яковлев^{3,4}, М.Вайер^{3,4}.*

Электрон-ядерное взаимодействия в X долине гетероструктур (In,Al)As/AlAs.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Санкт-Петербургский государственный университет, Петергоф;*

³ *Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург;*

⁴ *Technische Universität Dortmund, Dortmund, Germany.*

12¹⁵ – 12³⁰ ***Е.А.Емельянов**, М.О.Петрушков, И.Д.Лошкарев, А.В.Васев, Б.Р.Семягин, М.А.Путято, В.В.Преображенский*

МЛЭ твёрдых растворов GaP_xAs_{1-x} на вицинальных подложках: влияние отклонения на состав пленок
Институт физики полупроводников им. А.В.

Ржанова СО РАН, Новосибирск

12³⁰ – 12⁴⁵ ***А.Э.Климов^{1,2}**, В.А.Голяшов^{1,3}, Д.В.Горшков¹, Н.С.Пащин¹, Г.Ю.Сидоров¹, С.П.Супрун¹, В.Н.Шерстякова¹, О.Е.Терещенко^{1,3}.*

Чувствительность пленок PbSnTe:In к тепловому излучению низкотемпературных (вплоть до T=60K) источников.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск;*

³ *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*

12⁴⁵ – 13⁰⁰

М.О.Петрушков¹, Е.А.Емельянов¹, М.А.Путято¹,
А.В.Васев¹, А.К.Бакаров¹, А.К.Гутаковский¹,
О.С.Комков², Д.Д.Фирсов², Д.С.Абрамкин¹,
В.В.Преображенский¹

Искусственные подложки GaAs/Si(001), выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии, для оптоэлектронных приложений

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *ЛЭТИ, Санкт-Петербург*

13⁰⁰ – 14³⁰

Обед

3-е заседание Председатель – Якушев М.В.

14³⁰ – 15⁰⁰

В.И.Гавриленко¹, Р.А.Хабибуллин²

Российские квантовые каскадные лазеры ТГц диапазона (**приглашенный доклад**)

¹ *Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород;*

² *Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова РАН, Москва. (on-line)*

15⁰⁰ – 15³⁰

В.В.Преображенский, **И.Б.Чистохин**, М.А.Путято,
Н.А.Валишева, М.О.Петрушков, А.С.Плешков,
И.Г.Неизвестный, И.И.Рябцев

Конструкция и особенности изготовления детектора одиночных фотонов на базе лавинного фотодиода InP/InGaAs/InP для квантовых коммуникаций (**приглашенный доклад**)

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

15³⁰ – 15⁴⁵

О.Н.Шевченко^{1,2}, Н.А.Николаев^{1,2}, К.А.Кох^{2,3}.

Детектирование ТГц волн в кристаллах GaSe:S с помощью фемтосекундных лазерных импульсов на длине волны 1550 нм.

¹ *Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*

³ *Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск.*

15⁴⁵ – 16⁰⁰

А.Г.Милёхин^{1,2}, Н.Н.Курूसь¹, Л.С.Басалаева¹,

К.В.Аникин¹, Т.А.Дуда¹, Е.Е.Родякина^{1,2},

Р.Б.Васильев³, I.A.Milekhin⁴, M.Rahaman⁴, D.R.T.Zahn⁴,
А.В.Латышев^{1,2}.

Комбинационное рассеяние света полупроводниковых структур с нанометровым пространственным разрешением.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*

³ *Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва,*

⁴ *Semiconductor Physics, Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Germany.*

16⁰⁰ – 16¹⁵

С.А.Кузнецов^{1,2}, А.В.Гельфанд¹, **А.А.Мамрашев**³,
Ф.А.Минаков³, Н.А.Николаев^{2,3}.

Высокоэффективные поляризаторы с металлической решеткой на несущих полимерных пленках для широкополосной терагерцовой спектроскопии.

¹ *Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск;*

² *Аналитический и технологический исследовательский центр ФФ НГУ, Новосибирск;*

³ *Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.*

16¹⁵ – 16⁵⁰

Кофе-брейк

16⁵⁰ – 18³⁰ **Стендовая секция – 1.**